

# Silicon Diode

## **S431**

110V / 200mA

# DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



## Silizium-Planar-Diode

**S 431****Ausführung**

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehäuse. Kennzeichnung durch Farbringe — auf der Kathodenseite beginnend — nach dem internationalen Farbcode.

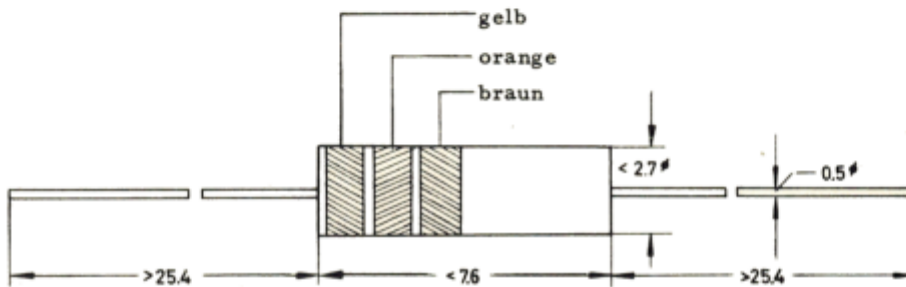
**Verwendung**

Hochsperrende Diode für allgemeine Anwendungen in der kommerziellen Technik.

**Abmessungen**

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7

**Grenzdaten**

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	250	mW
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	$U_R$	110	V
Spitzensperrspannung		$U_{RM}$	150	V
Durchlaßgleichstrom		$I_F$	200	mA
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_j$	150	°C
Minimale Gehäusetemperatur		$-T_G$	55	°C
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	150	°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55	°C

**S 431****Statische Kenndaten bei  $T_U = 25\text{ °C}$** 

Sperrstrom	$U_R = 110\text{ V}$	$I_R$	$< 100$	nA
Durchlaßstrom	$U_F = 1\text{ V}$	$I_F$	$> 100$	mA
Wärmewiderstand		$R_{thU}$	0,5	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

**Dynamische Kenndaten bei  $T_U = 25\text{ °C}$** 

Diodenkapazität	$U_R = 10\text{ V}$ $f = 0,5\text{ MHz}$	C	$< 10$	pF
-----------------	---	---	--------	----

